



Rys. 42.19. Tranzystor MOSFET — szczególny typ tranzystora polowego. Natężeniem prądu I_{DS} płynącego kanałem typu n można sterować zmieniając różnicę potencjałów V_{GS} przyłożoną pomiędzy źródłem S a bramką G . Obszar zubożony istniejący pomiędzy materiałem typu n i podłożem typu p nie został pokazany